

勘误表

MM32F0020 Rev 1.1

灵动微电子有权在任何时间对此文件包含的信息(包括但不限于规格与产品说明)做出任何改动与发布,本文件将取代之前所有公布的信息。



目录

1	概述		3
		案	
	3.1.1	Flash 擦写过程中复位导致异常	5
	3.1.2	使能读保护后在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存进行页擦除、	编程
	或读取操	作	5
	3.1.3	使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID	5
4	修改记录		6



1 概述

本勘误表描述了 MM32F0020 系列产品所有已知的功能性问题,旨在为用户提供该产品的勘误信息与相应解决方案。

表 1 适用系列型号

系列	型号
MM32F0020	最新型号列表请参考 MM32F0020 系列数据手册

Rev 1.1 <u>www.mm32mcu.com</u> 3



2 总览

表 2 勘误表总览

功能模块	简述	版本	详细描述
Flash	Flash 擦写过程中复位导致异常	Α	3.1.1
Flash	使能读保护后在 SRAM 中执行的程序 无法对主闪存进行页擦除、编程或读取 操作	А	3.1.2
Flash	使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID	Α	3.1.3

其中,版本一栏中的字母表示会出现该现象的芯片版本号。芯片版本号信息可在芯片 丝印中找到,具体信息请参考 MM32F0020 系列数据手册第 2.2 小节"丝印信息"。

Rev 1.1 <u>www.mm32mcu.com</u> 4



3 问题与解决方案

3.1 Flash

3.1.1 Flash 擦写过程中复位导致异常

问题:

Flash 擦除和编程过程中如果有复位产生(包括外部复位引脚产生的复位、看门狗复位等),可能会导致芯片复位后工作异常。

解决方案:

Flash 擦除和编程过程中需避免复位的产生;芯片可以通过掉电再上电恢复正常。

3.1.2 使能读保护后在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存进行页擦 除、编程或读取操作

问题:

芯片读保护使能后,在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存(Main Flash)进行页擦除、编程或读取操作,全片擦除操作不受影响。

解决方案:

在使能读保护功能的场景中,对主闪存进行页擦除、编程或读取操作的程序,需要放置在主闪存区域执行。

3.1.3 使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID

问题:

当芯片读保护使能时,将无法通过 SWD 接口读取到芯片的 UID。

解决方案:

如果需要从 SWD 读取到芯片 UID, 需先解除芯片读保护。



4 修改记录

表 3 修改记录

日期	版本	内容
2023/2/23	1.1	新增勘误信息使能读保护后在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存进行页擦除、编程或读取操作和使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID
2022/6/13	1.0	新建勘误表

Rev 1.1 <u>www.mm32mcu.com</u> 6